(19)日本国特許庁(JP)

4

(12) 特 許 公 報(日2)

(11) 特許番号

特許第3128645号 (P3128645)

(45)発行日 平成13年1月22日(2001.1.22)

(24) 發展日 平成12年11月2日(2000.11.2)

FI H01L 21/30

518

G03F 7/20

F 7/20 521

G0 3 F 7/20

621

5-1

競求項の数15(全 4 頁)

(21) 出職番号

(22) 出劃日

特証平7-308519

平成7年11月2日(1995.11.2)

(B5)公開福号 (43)公開日 · 特房平9-129547

平成3年5月16日(1997.5.16) 平成16年8月25日(1998.8.25)

・ 日報金舗金舗

東京都大田区下丸于3丁目30番2号 (72)発明者 職局 純二

職者 純二 特奈川県川崎市中原区今井上町空港地半

ヤノン株式会社小杉本東所内

(72)発明者 七五三木 造一

(73)特許権者 000001007

神奈川県川崎市中原区今并上町53番地中

ヤノン株式会社小杉本業所内

(74)代差人 100096287

护理士 伊東 哲也

キヤノン株式会社

客查官 岩木 盤

(68)参考文獻

特票 平4−196578 (IP, A)

特長 平7-249587 (JP, A)

入れ万に対く

(54) [発明の名称] 走査型館光技量、デバイス製造方法およびデバイス

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 原版を移動させる第1の移動手段、前記原版の位置を計測する第1の計測手段、基版を移動させる第2の移動手段、前記基版の位置を計測する第2の計測手段、前記原版上のパターンを照明する照明光学系、および前記第1計測手段と第2計測手段の計測値に基づいて前記第1移動手段と前記第2移動手段の駆動を制御する制御手段を有し、前記原版と基板を位置的に整合した状態で前記照明光学系に対して相対的に移動しながらスキャン露光することにより前記原版上のパターンを前記基板上に転写する走査型量光装置において、

村記第1計測手段と村記第2計測手段間の相対位置を計 測する第3の計測手段を有し、前記制御手段は、前記相 対位置をも考慮して前記第1移動手段または第2移動手段を驅動することにより前記相対位置の変化により生じ る前記整合状態の誤差を補正するものであることを特徴とする走査型露光装置。

【請求項2】 前記第3計測手度は、前記第1または第 2計測手段の近傍に固定されたレーザ干渉計であり、そ の近傍に位置しない前記第2または第1計測手段の位置 を計測するものであることを特数とする請求項1記載の デバイス製造装置。

【請求項3】 前記スキャン露光を前記基板をステップ 送りすることに繰り返すステップアンドスキャン方式の ものであることを特徴とする請求項「記載の走変型露光 装備。

【請求項4】 投船光学系を有し、前記スキャン露光 は、この控船光学系を介して行うことを特徴とする請求 項1記載の走空型露光装置。

【請求項5】 前記投影光学系は、ミラー投影光学系で

あることを特徴とする請求項4記載の走査型露光装置。 【請求項6】 前記投配光学系は、レンズ投配光学系であることを特徴とする請求項4記載の走査型露光装置。 【請求項7】 前記控配光学系は、第小投配光学系であることを特徴とする請求項4~5記載の走査型露光装置。

【詩求項 8】 原版の位置および基板の位置をそれぞれ第1および第2の計測手段により計測しつつ、その計測 結果に基づいて前記原版および基板を位置的に整合した 状態で照明光学系に対して相対的に移動させながらスキャン露光することにより前記原版上のパターンを前記基 坂上に転写するデバイス製造方法において、

第3の計測手段により前記第1および第2計測手段間の 相対位置を計測しつつ、この計測結果にも基づいて付記 整合した状態での移動を行うことを特徴とするデバイス 製造方法。

【請求項9】 前記第3計測手段は、前記第1または第2計測手段の近例に固定されたレーザ干渉計であり、その近例に位置しない前記第2または第1計測手段の位置を計測するものであることを特徴とする請求項8記載のデバイス製造方法。

【諸求項10】 前記スキャン露光を前記基板をステップ送りするごとに繰り返すステップアンドスキャン方式の露光を行うことを特徴とする諸求項8記載のデバイス製造方法。

【請求項11】 投影光学系を有し、前記スキャン露光 は、この投影光学系を介して行うことを特徴とする請求 項8記載のデバイス製造方法。

【諸求項12】 | 対記投影光学系は、ミラー控影光学系 であることを特徴とする諸求項11記載のデバイス製造 方法

【請求項 1/3 】 付記投影光学系は、レンズ投影光学系 であることを特徴とする請求項 1 1記載のデバイス秘書 セは

【請求項14】 前記投船光学系は、縮小投船光学系であることを特徴とする請求項11~13記載のデバイス製造方法。

【請求項15】 原版の位置および基板の位置をそれぞれ第1および第2の計測手段により計測しつつ、その計測結果に基づいて前記原版および基板を同期させて移動させながら、前記原版のパターンを前記基板上にスキャン露光するデバイス製造方法であって、第3の計測手段により前記第1および第2計測手段間の相対位置を計測しつつ、この計測結果にも基づいて前記同期した移動を行うデバイス製造方法により製造されることを特徴とするデバイス

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体素子、液晶パネル等の製造に使用される走査型露光装置およびそれ

· ...

を用いたデバイス製造方法ならびにその製造方法により 製造されるデバイスに関するものである。

[0002]

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】従 来、半導体素子、液晶パネル等を露光する方式として は、控影光学系を介し、マスクと基板(またはウエハ) をキャリッジ上に載せて一体的に移動 させながら走査録 光することによりマスク全面の食を茎板上に転写する方 式がある。しかし、最近の動向としては、基板を大型化 し、1枚の基板から取得できる液晶パネルの枚数を増や すことにより液晶パネルのコストを下げる方向に向かっ ている。その際生じる問題として基板が大型になること により、マスクと基板を一体で保持しているキャリッジ の重量が増加するという問題がある。その結果、キャリ ッジを高速で制御することが困難になり、スループット が大幅に低下してしまう。その対策として、マスクと基 板のそれぞれに個別の走査ステージ、駆動系およびレー ザ干渉計を設け、同期駆動によりマスクの像を基板上に 転写する方式がある(特公平5-15054号公報)。 この方式の場合、従来のマスクと基板を連結するキャリ ッジが必要なくなり走査重量は大幅に退少する。それに より、マスクと萎板の同期を高速で制御することが可能 になり、スループットは大幅に向上する。しかし新たに 発生する問題もある。すなわち、走査中のマスクの位置 を計測するレーザ干渉計の干渉部分を取り付けている本 体構造体の箇所Aと走査中の基板の位置を計測するレー ザ干渉計の干渉部分を取り付けている本体構造体の箇所 Bが、移動体の移動に伴う重量移動や移動体の加速時の 反力により本体構造体の箇所AおよびB間に相対位置変 **让が生じる。その結果、マスクと基板との間に同期位置** 誤差が発生し、オーバーレイ精度が劣化する。

【0003】これを、図2を用いて具体的に説明する。 図2は従来側に係る露光装置の構成を示す。図中、1は 焼付パターンが形成されているマスク、2はマスク1を 搭載してX、Yおよび8方向に移動可能なマスクステー ジ、3は液晶表示板を製造するためにその表面に多数の 画素とこれらの画素のオンまたはオフを制御するための スイッチングトランジスタが通常のフォトリングラフィ の手段で形成されるガラス基板。 4 は基板3 を保持して X、Yおよび9方向に移動可能な基板ステージである。 【0004】5は特定の波長の光で露光位置にあるマス ク1を照明する照明光学系であり、マスク1上のパター ンを介して基振3上の歴光層を露光することにより、マ スク1上のパターンを基振3に転写可能とするためのも のである。6は凹面鏡であり、凸面鏡7および折曲げ鏡 8 との組合わせにより周知のミラー投影系を構成し、マ スクステージ2によって所定位置にアライメントされた マスク 1のパターン像を基板3上に等倍投影するもので

【0005】9は萎板ステージ4を載置しているベース

定盤であり、10はマスクステージ2が転置されているマスクステージ2盤である。マスクステージ2盤10は 連結版 11によりペース定盤9と連結されている。12 および14はそれぞれマスクステージ2および基板ステージ4を×方向に移動させるためのモータである。13 および15はそれぞれ各ステージ2および4すなわちマスク1および基板3の位置をモニタするための測長器であり、例えばレーザ干渉計である。

[0005] 16は、走査露光時、レーザ干渉計13および15のステージ位置情報を基にモータ12および14の駆動量を制御することにより、ステージ2および4を互いに開始させて移動する料御回路である。料御回路16は、例えばモータ12を一定電圧で駆動してマスクステージ2を定速走行させ、レーザ干渉計13および15で計測されるステージ2および4の位置に応じた駆動量をモータ14に供給して基板ステージ4を移動する。この場合、もステージの移動速度は、必ずしも同一である必要はなく、適当な速度比を持たせても良い。

【0007】この制御方式の場合に発生する問題として、マスクステージ2および基板ステージ4の移動中の位置をモニタする測長器13および15を取り付けている部材間で、移動体の移動に伴う重量移動、または移動体の加速時の反力により相対位置変化が生じる。その場合、上記制御方式では相対位置変化は補正できず、その相対位置変化量だけマスク1と基板3の間に同期位置設置が発生し、マスクのパターンが基板の所定の位置に転写できない。その結果、画素を制御するためのスイッチングトランジスタの特性不良が発生する。

【0008】本発明の目的は、このような従来技術の問題点に鑑み、高精度な露光証写を可能にし、半導体素子の高集積化および液晶表示板の高精細化に対応できる定登型露光萎縮を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手度および作用】この目的を達成するため、本発明の走産型素光装置は、原版を移動させる第1の移動手段、原版の位置を計測する第1の計測手段、原版上のパターンを照明の位置を計測手段を新ませる第2の移動手段、基板の位置を計測手段、原版上のパターンを照明の計測・6年間の一個では、10年間の一個である。10年間の一個であることでは、10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個では、10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個である。10年間の一個では、10年間の一個では、10年間の一個では、10年間の一個である。10年間の一個では、10年間のでは、10

【ロロ10】また、第3計測手段は、第1または第2計

測手段の近傍に国定されたレーザ干渉計であり、その近 傍に位置しない第2または第1計測手段の位置を計測す るものであることを特徴とする。

[0011]また、スキャン露光を基板をステップ送り するごとに繰り返すステップアンドスキャン方式のもの であることを特徴とする。

【0012】また、投影光学系を有し、スキャン露光は、この投影光学系を介して行うことを特徴とする。

【0013】また、投影光学系は、ミラー投影光学系であることを特徴とする。

【ロロ14】また、投舵光学系は、レンス投船光学系であることを特徴とする。

【0015】また、投影光学系は、縮小投影光学系であることを特徴とする。

【0016】また、本発明のデバイス製造方法は、原版の位置および基板の位置をそれぞれ第1および第2の計 潮手度により計測しつつ、その計測結果に基づいて原版 および基板を位置的に整合した状態で照明光学系に対し で相対的に移動させながらスキャン露光することにより 原版上のパターンを基板上に転写するデバイス製造方法 において、第3の計測手段により第1および第2計測手 機関の相対位置を計測しつつ、この計測結果にも基づい で整合した状態での移動を行うことを特徴とする。

【0017】また、第3計測手段は、第1または第2計 瀬手段の近傍に固定されたレーザ干渉計であり、その近 傍に位置しない第2または第1計測手段の位置を計測す るものであることを特徴とする。

【0018】また、スキャン露光を萎板をステップ送り するごとに繰り返すステップアンドスキャン方式の露光 を行うことを特徴とする。

[0019]また、投影光学系を有し、スキャン露光は、この投影光学系を介して行うことを特徴とする。

[.0020] また、投影光学系は、ミラー投影光学系であることを特徴とする。

[0021] また、投配光学系は、レンズ投影光学系であることを特徴とする。

【0022】また、投影光学系は、箱小投影光学系であることを特徴とする。

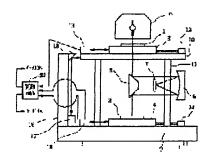
【0023】また、本発明のデバイスは、原版の位置および基板の位置をそれぞれ第1および第2の計測手度により計測しつつ、その計測結果に基づいて原版および基板を同類させて移動させながら、原版のバターンを基板上にスキャン露光するデバイス製造方法であって、第3の計測手段により第1および第2計測手段間の相対位置を計測しつつ、この計測結果にも基づいて同期した移動を計測しつつ、この計測結果にも基づいて同期した移動を計測して、表別では、1000円間により製造されることを特徴とする。

【0024】これにより、第1計測手段と第2計測手段 間の相対位置変化、すなわち、これら計測手段が設置された本体構造体の変形による同期誤差が補正される。

[0025]

【実施例】図1は、本発明の一実施例に係る露光装置の 構成を示す図である。この装置では、図2のものに対し て次のような要素17~20が追加されている。 すなわ 5.1.7 は瀕長器、例えばレーザ干渉計であり、萎振ステ ージ4の位置を計測するための計測器15の近傍に取り 付けられ、ベース定盤 9上に取り付けられている架台 1 9に固定されている。測長器17は製台19に固定され ている折曲げミラー 18を介して、マスクステージ2の 位置を計測する計測器13が固定されたマスクステージ 定盤10の位置の変化を測定するための測定器である。 制御官路20は、走査露光時、レーザ干渉計13および 15のステージ位置情報とレーザ干渉計17の本体構造 体の祖対位置変化情報を禁にモータ12および14への 駆動量を制御することにより、 ステージ2 および4 を互 いに関期させて移動する。より具体的には、例えばモー タ12を一定電圧で駆動してマスクステージ2を定道走 行させ、レーザ干渉計13および15で計測されるステ ージ2 および 4の位置に応じた駆動量にレーザ干渉計 1 7 で計測された位置の変化量に見合った駆動量を加算し た駆動量をモータ1.4に供給して基板ステージ4を移動 すればよい。なお、上述においては挫更光学系としてミ ラー投影光学系を用いているが、この代わりにレンス投 影光学系を用いることも可能である。また、本体構造体 の変形量を測定する測長器は必ずしもレーザ干渉計に限 らず、静電容量センサ等の微小変位測定器でもよい。

[図 1]



[0026]

【発明の効果】以上説明したように本発明では、第1計 測手段と第2計測手段間の相対位置を計測する第3の計 測手段を有し、その相対位置をも考慮して第1移動手段または第2移動手段を駆動することにより相対位置変化により生じる同期誤蓋を補正するようにしたため、原版(マスク)と基板(ウエハ)のそれぞれの位置を計測するための計測器を取り付けている本体構造体が走査露光時の相対位置変化による同期位置誤蓋を補正することが可能となり、マスクのバターンを基板上に高い配置精度で転写することができる。これにより今後ますまず進むであろう半導体兼子の高乗技化、液晶表示板の高精細化に十分対応可能である。

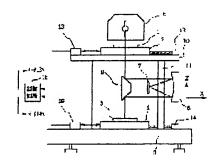
【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例に係る露光装置を示す概略 構成図である。

【図2】 従来側に係る露光装置を示す概略構成図である。

【符号の説明】

[図2]



フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.7, DB名) HO1L 21/027